課題番号 : F-20-WS-0136

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :薄膜ヒーターの作製

Program Title (English) : Fabrication of thin film heaters

利用者名(日本語) : 滝口広樹、古谷正裕

Username (English): H. Takiguchi, M. Furuya所属名(日本語): 早稲田大学先進理工学研究科

Affiliation (English) : School of Advanced Science and Engineering, Waseda University

キーワード/Keyword :成膜・膜堆積、スパッタ、BaTiO3

1. 概要(Summary)

イオンビームスパッタ装置を用いてチタン酸バリウム (BaTiO₃) 薄膜の製膜を行った。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

イオンビームスパッタ装置、

表面極微細構造測定装置(テンコール)

【実験方法】

20mm \square の Si 基板上にイオンビームスパッタ装置を用いて BaTiO $_3$:Mo を製膜した。引き出し電圧 950~V、イオンビーム電流 80~mA、Ar 流量 15~sccm、圧力 4×10^{-4} Torr、製膜時間 37.5~min.で基板回転を行いながら製膜を行った。基板加熱は行わなかった。膜厚測定のため基板の中央にマスクを施した。製膜後にマスクを剥離し、表面極微細構造測定装置を用いて BaTiO $_3$:Mo 薄膜の膜厚を測定した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

製膜した $BaTiO_3$: Mo 薄膜を Fig.~1 に示す。基板表面の緑色の部分が製膜した $BaTiO_3$: Mo 膜である。基板中央部分は製膜後にマスクを剥離した箇所で、Si 基板の面が表れている。マスク剥離箇所の段差より $BaTiO_3$: Mo 薄膜の膜厚を表面極微細構造測定装置を用いて測定した。 3 点で測定を行った結果、 $BaTiO_3$: Mo の膜厚はそれぞれ 407 nm、405 nm、435 nm で、平均膜厚は 415.7 nm であった。

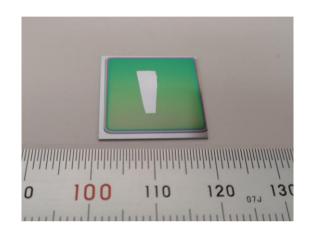


Fig. 1 A BaTiO₃:Mo thin film deposited by Ion beam sputtering system.

4. その他・特記事項(Others)

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。